

Germanium PNP Transistor

GF128

25V / 10mA

DATASHEET

OEM – RFT

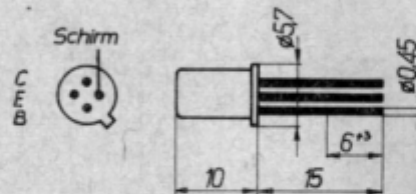
Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72

GF 128

Nicht für Neuentwicklung

RFT
electronic

Germanium - pnp - Legierungs - Diffusions - Transistor der Bauform A 4/15 - 4b nach TGL 11 811 für Verstärkerstufen bei 37 MHz.



Masse ca. 0,6 g

Grenzwerte


Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	= 25 V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CER}$	= 20 V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	= 0,5 V
Gesamtverlustleistung	P_{VL}	= 50 mW
Kollektorstrom	$-I_{CL}$	= 10 mA
Emitterstrom	I_{EL}	= 11 mA
Basisstrom	$-I_{BL}$	= 1 mA
Sperrschichttemperatur	ϑ_{jL}	= 75 °C
Umgebungstemperatur	ϑ_{aL}	= 65 °C
Wärmewiderstand	R_{Thja}	≤ 0,6 grd/W

8.69

62

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)



RFT electronic		GF 128 Nicht für Neuentwicklung		
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 6\text{ V}$	$-I_{CBO}$			$7,5\ \mu\text{A}$
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 25\text{ V}$	$-I_{CBO}$			$100\ \mu\text{A}$
Emitter-Basis-Reststrom $-U_{Eb} = 0,5\text{ V}$	$-I_{EBO}$			$100\ \mu\text{A}$
Dynamische Kennwerte				
Übergangsfrequenz $-U_{CE} = 10\text{ V}$ $-I_C = 3\text{ mA}$ $f = 100\text{ MHz}$	f_T		100 MHz	
Kurzschlußstromverstärkung $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 1\text{ mA}$	h_{21E}		40	
Rückwirkungszeitkonstante $-U_{CB} = 10\text{ V}$ $-I_C = 3\text{ mA}$ $f = 30\text{ MHz}$	$\frac{ h_{21b} }{\omega}$			24 ps
Vierpolparameter $-U_{CE} = 10\text{ V}$ $-I_C = 3\text{ mA}$ $f = 37\text{ MHz}$	g_{11e} C_{11e} y_{21e} g_{22e} C_{22e}	5 mS 12 pF 40 mS 83 μS 1,5 pF	11 mS 30 pF 60 mS 160 μS 2,5 pF	25 mS 80 pF 360 μS 4,5 pF
Leistungsverstärkung $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 1\text{ mA}$	G_{pe}		40 dB	42 dB
Bestellbeispiel für einen Transistor		Transistor GF 128		
	KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) Stammtrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)	8.69 63		